# KEKB入射器用 S バンド 2m 加速管の高電界試験

五十嵐 康仁<sup>1,A)</sup>、山口 誠哉<sup>B)</sup>、大越 隆夫<sup>B)</sup>、柿原 和久<sup>B)</sup>、東 保男<sup>B)</sup>、大沢 哲<sup>B)</sup>、榎本 收志<sup>B)</sup> 富沢 宏光<sup>C)</sup>、谷内 努<sup>C)</sup>、花木 博文<sup>C)</sup>

A) 総合研究大学院大学 加速器科学専攻 (SOKENDAI)

<sup>B)</sup> 高エネルギー加速器研究機構 (KEK)

〒305-0801 茨城県つくば市大穂1-1

<sup>C)</sup>(財)高輝度光科学研究センター 放射光研究所 加速器部門 (SPring-8) 〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都1-1-1

# 概要

KEKB入射器用S バンド 2 m 加速管の高電界試験 を行った.高電界試験は3種類の加速管について, エージング時間と加速電界強度,放電頻度,電界増 倍係数および加速管の上流,下流側で観測される暗 電流の総電荷量の関係を詳細に調べた.特に超純水 高圧洗浄を行った加速管は他の加速管に比べて半分 以下のエージング時間で45 MV/mに到達することが できた.また電界放出電子による暗電流の運動量ス ペクトルのシミュレーションと試験結果の比較を 行った結果も報告する.

# 1. 加速管の高電界試験

### 1.1 試験加速管

KEKB入射器用Sバンド2m加速管は54空洞と入出 カカプラーから成る準定電界型である(2π/3モード, 2856MHz).本加速管は電鋳法によって空洞を一体化 している.入出力カプラー空洞には径方向の電磁場 分布非対称性補正用の三日月型窪みがある[1].高電 界試験は3種類の加速管について行った.Type(1): KEKB入射器で使用されている標準タイプの加速管. Type(2):入出力カプラー空洞の三日月型窪みを無く したタイプ.電磁場分布は非対称のまま.Type(3): 超純水高圧洗浄を行った加速管で構造はType(1)と同 じ.超純水高圧洗浄(HPR)技術は空洞内面を超純水 で洗浄し,電界放出の原因の一つで



図 1: 2m加速管の超純水高圧洗浄.

<sup>1</sup> E-mail: yasuhito.igarashi@kek.jp

ある塵などの汚染物を取り除く方法である.この技術を2m加速管に適用した(図1)[2].予備試験の結果, HPRによってサンプルディスク上の不純物の数が 1/10以下に減少することが確認されている[1].

#### 1.2 試験結果

RFパルスの繰り返しは50 pps,パルス幅は4 µsec に固定した.はじめはSLEDを離調して徐々にRF電 力を上げ,その後,SLEDを同調した.試験中は常 にクライストロンへのRF反射量(VSWR)と加速管等 の真空圧力を計測しインターロックに用いた.電界 放出電子による暗電流の全電荷量は加速管の上下流 に設置したファラデーカップで,その運動量スペク トルは45°偏向磁石,スリットおよびファラデー カップを用いて測定した.

表1に試験結果を、ショット数と平均加速電界強 度 E 及び電界増倍係数 β との関係を図2,3 に示す (βはType(3)のみ示す). 試験の結果,3種類の加速管 とも40 MV/m以上の平均加速電界強度を得ることが 出来た.特に,超純水高圧洗浄を行った加速管は他 の加速管に比べて半分以下の時間で45 MV/mに到達 し、放電回数、暗電流値とも1/3以下という結果で あった. 試験設備の制限によってこの値以上の試験 を行うことは出来なかったが、45 MV/m以上の加速 電界強度も十分に可能であると思われる.また,β はエージングが進むにつれて指数関数的に減少して いることがわかる.もし、 $\beta = \beta_0 \exp(-t/\tau)$ ( $\tau$ :時定 数)であると仮定すると半減期T<sub>1/2</sub> (=(ln2)\_τ)は Type(1),(2),(3) (下流側のみ)でそれぞれ784, 1677, 341時間となりType(3)は他に比べて半分以下の時間 となる.

表1:3種類の加速管の試験結果.

Туре	Time [hours]	Shot $[\times 10^7]$	Maximum average field [MV/m]	Peak curren up	dark it [µA] down	up	ß down
(1)	572	10.3	$40^{*}$	569	631	52	53
(2)	811	14.6	45	722	1130	54	55
(3)	356	6.4	45	295	224	68	53

\*:日程的な理由により制限された.





Type(3)の試験時に、4重極型質量分析器(QMS)を 組み込んで残留ガスの分圧を測定した.加速管内で 放電が起きたときに発生した脱ガスの質量スペクト ルの一例(E = 45 MV/m)を図4に示す.実線が定常状 態,点線が放電時のスペクトルを表し、全圧はそれ ぞれ約2×10<sup>6</sup> Pa、約1×10<sup>5</sup> Paであった.放電時に は2 ( $H_2$ )と28 (CO-N<sub>2</sub>など)が最も上昇し、次いで44 (CO<sub>2</sub>)とC<sub>k</sub>H<sub>1</sub>(炭化水素)が上昇している.これらは放 電による電子衝撃で吸着水分子が解離し、汚染分子 のCと結合してH<sub>2</sub>,CO,C<sub>k</sub>H<sub>1</sub>等として脱離してい くためと考えられる.一方、18 ( $H_2$ O)、17 (HO)は放 電時にほとんど変化していない.また、放電発生時 の発光を観測してその分光特性の解析を行った結果, Cu I,Cu II,C I,H $\alpha$ ,O I のラインが確認され, QMSの測定データと一致した[3].

高電界試験後に加速管の位相特性を測定した. 試 験後の加速管には目視できた範囲では放電痕のよう なものは無く位相変化を伴うようなダメージは無い と思われるが確認のために行った. Type(1)について はすでに加速器運転で使用されているため他の2本 の加速管について測定を行った.非共振摂動理論に 基づくビード摂動法によって各空洞での電場の位



図4:定常時と放電時の残留ガス質量スペクトル.



図5:高電界試験前後における各空洞の位相変化量 (入出力カプラー空洞は除く).

相を求め、高電界試験前後での比較を行った結果を 図5に示す.ほとんど位相の変化は見られなかった.

### 1.3 加速電界強度と放電頻度との関係

各加速管の試験の最後に、入力RF電力の値を下げ ながら放電が起こる頻度を調べた. 図6にType (2)の 結果を示す.図の上側の●点はエージングを行って いる時の放電頻度を表し.1時間当たりの放電回数 が10回前後となっているのは、放電回数がこの頻度 に収まるようにエージングを進めているためである. 1度エージングが済んだ電界強度では放電頻度が大 きく下がることがわかる. また, Type(2)とType(3)で は、最大平均加速電界強度45 MV/mまでに到達する 時間が約810時間と約350時間で2倍以上異なってい るにもかかわらず、45 MV/m到達後に入力RF電力の 値を下げながら測定した平均加速電界強度と放電頻 度との関係が同じ傾向となった.このことは、加速 管の放電頻度はエージングを行った時間数よりも加 速管に投入した最大RF電力値が大きく影響すること を示していると考えられる.



図6:平均加速電界強度と放電が起こる頻度の関係.

## 2. 暗電流の運動量スペクトル

電界放出電子による暗電流の運動量スペクトルの シミュレーションを行い、高電界試験結果との比較 を行った.計算には電子軌道,エネルギースペクト ル計算用のコードを用いた[4].加速管下流側で測定 したType(3)の試験結果と計算の比較を図7に示す. 約 20 MeV/c以下で計算(破線)は左上がりだが試験結 果(点線)は下がっている.この計算では最下流に到 達した全ての電子によって運動量を求めているため にビームホール、スリット等でトラップされる影響 が含まれていない. その為, 最下流に到達した電子 の位相空間分布を計算し,運動量と位置(半径方向)x, 傾き x'との関係を図8に示す. 半径方向への広がり はほぼディスク孔径内(a = 11.875 mm)に収まってい るが、約20MeV/c以下では傾きが大きいことわかる. そこでスリットまでの距離、スリット幅を考慮して 最下流に到達した電子の中で, x < a [mm], x' < 17 [mrad]の範囲にある電子で求めた運動量を図7(実線) に示す.その結果,低エネルギー側の分布が計算と 試験結果でほぼ同じ傾向となる.又,下流側3空洞 での暗電流の軌道(図9)からも下流側で計測される暗 電流は方向の揃った電子であることがわかる.一方, 高エネルギー側の分布は計算と比べて試験結果が下 がっている.計算ではディスク孔径が一定である加 速管を計算しているが、実際の加速管はディスク孔 径が段々と小さくなっている. その為, 上流側で放 出された電子ほど途中のディスクでトラップされる 確率が高くなり、最下流まで到達する高エネルギー 側の電子の数が少なくなると考えら



図7:加速管下流側での運動量スペクトルの試験結 果とシミュレーションの比較 (E=42 MV/m).



図8:加速管の最下流,最上流に到達した電子の運動量と位置x,傾きx'との関係.

れる.同様に,加速管の最上流に到達した電子の位 相空間分布を計算した(図8).運動量は約6 MeV/c以 下であり,下流側と比べて半径方向への広がり,傾 きとも大きい.又,それは上流側3空洞での暗電流 の軌道(図9)からもわかる.Type (3)の試験結果と計 算の比較を図10に示す.スペクトル分布は低エネル ギー側のみであり傾向は試験結果とほぼ一致してい る.従って,最上流に到達する多くの電子は上流側 の数空洞から放出さていることになり,上流側の電 界増倍係数  $\beta$ は加速管上流側の数空洞の状態を表す と考えられる.それに対して下流側の $\beta$ は約20~40 空洞付近の状態を表していることになる.









## 3. まとめ

3種類の加速管について高電界試験を行った結果, 3種類の加速管とも40MV/m以上の平均加速電界強度 が得られた.特に超純水高圧洗浄を行った加速管は 他に比べて半分以下の時間で45MV/mに到達し,放 電回数,暗電流値とも1/3以下という結果であった. 電界増倍係数  $\beta$  はエージングが進むにつれて指数 関数的に減少し,また加速管の放電頻度はエージン グを行った時間数よりも投入した最大RF電力値が大 きく影響することがわかった.電界放出電子による 暗電流の運動量スペクトルのシミュレーションを 行った結果,測定結果のスペクトル形状を再現した.

# 参考文献

- Y. Igarashi, et al., "High-gradient Tests on an S-band Accelerating Structure", Proc. of the LINAC'02, TH403.
  Y. Igarashi, et al., "High-Gradient Tests on S-band 2m-
- [2] Y. Igarashi, et al., "High-Gradient Tests on S-band 2mlong Accelerating Structures for KEKB injector linac", Proc. of the PAC'03, RPAB050.
- [3] H. Tomizawa, et al., "Atomically spectroscopic approach for diagnostics of rf breakdown in accelerating rf structures", Proc. of the 8th European Vacuum Congress, 2003.
- [4] S. Yamaguchi, "Simulation Studies on High-Gradient Experiments", LAL/RT 92-18, 1992.